(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平4-373131

(43)公開日 平成4年(1992)12月25日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 L 21/321

9168-4M

H01L 21/92

С

## 審査請求 未請求 請求項の数2(全 3 頁)

(21)出願番号

特願平3-177368

(22)出願日

平成3年(1991)6月22日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 江川 秀範

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

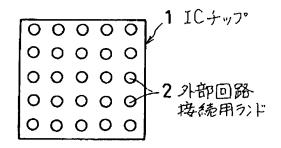
(74)代理人 弁理士 鈴木 章夫

## (54) 【発明の名称】 高密度実装用 I Cペレツト

## (57) 【要約】

【目的】 バンプを充分な大きさに形成するとともに、 隣接するバンプの短絡を防止して高信頼度での実装を可 能にし、かつランドを規格化してマスクやプローブカー ドの共用化を可能にした I Cベレットを得る。

【構成】 複数個のランド2をICペレット1の略全面にわたって所定のピッチ寸法でマトリックス状に配置する。このため、ランドの面積及びピッチ寸法を増大して信頼性の高い実装を可能とし、かつランドを規格化してマスクやプローブカードの共用化を可能とする。又、ランドに形成するパンプの潰れを防止して安定な実装状態を得ることが可能となる。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数個の外部回路接続用ランドを表面に 配列したICペレットにおいて、前記ランドをICペレ ットの略全面にわたって所定のピッチ寸法でマトリック ス状に配置したことを特徴とする高密度実装用ICペレ ット。

【請求項2】 外部回路接続用ランドは、ウェハ全面に わたって等ピッチ寸法のマトリックス状に形成してなる 請求項1の高密度実装用ICペレット。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はICペレットに関し、特 にハイブリットIC等に用いられて半田パンプ等を用い て高密度に実装を行うためのICペレットに関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来のICペレットは、図4に示すよう に、ICペレット11の表面に複数個の外部回路接続用 ランド(以下、ランドと略称する)12が配設されてい るが、各ランド12はICペレット11の周辺部にのみ 設けられており、かつ隣接するランドのピッチ寸法も不 20 定であった。これは、従来の外部回路接続技術の主流 が、外部回路接続用ランド12にアルミニウム線や金線 等を用いたワイヤーポンディングであったことによる。 具体的には、ランド12は約 100μm□程度の大きさと され、ICペレット11の外周から約 100~ 200μm程 度の部分に内部パターンを囲むように配置される。又、 ICペレット11自体の寸法及び必要ランド数に応じて ランドの配置は異なっており、特にメモリチップのよう に、ICペレットの一つの辺にランドが集中して配置さ れるものがある。

## [0003]

【発明が解決しようとする課題】このように従来のIC ペレットでは、ランド12がICペレット11の各辺に 沿った領域に一列に並んで配列されるため、多数のラン ドが必要とされるときにはランドのピッチ寸法及びラン ドの面積が共に小さくなる。したがって、図5に示すよ うに、ランド12に例えば半田でパンプ14を形成し、 このパンプ14をハイブリッド基板15に接続して実装 を行う場合には、信頼性の高い大きさのパンプを形成す ることが難しく、又隣接するパンプが互いに接触して短 40 絡不良が発生し易いという問題がある。

【0004】又、ICペレットの種類毎に各ランドの位 置が相違されるため、バンプ形成の際にはその都度専用 マスクが必要となる。同様に、各ランドに検査針を接触 させて行う機能検査時には、各ICペレットのランド配 置に合った専用プロープカードが必要となるという問題 もある。更に、ICペレットの大きさに対してランドの 数が極端に少ない場合や、位置に偏りがある場合には、 1つのパンプ当たりの荷重が大きくなり、パンプが潰れ る等、安定した接続条件を得るのが難しくなるという問 50

題もある。本発明の目的は、高信頼度での実装を可能に するとともに、マスクやプロープカードの共用化を可能 にしたICペレットを提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明のICペレット は、複数個のランドを、ICペレットの略全面にわたっ て所定のピッチ寸法でマトリックス状に配置する。この ランドは、ICペレットを個片に切断分離する前のウェ ハ状態において、ウェハ全面にわたって等ピッチ寸法の 10 マトリックス状に形成する。

[0006]

【作用】本発明によれば、ランドの面積及びピッチ寸法 を増大して信頼性の高い実装を可能とする。又、ランド を規格化してマスクやプローブカードの共用化を可能と する。更に、ランドに形成するパンプの漕れを防止して 安定な実装状態を得ることが可能となる。

[0007]

【実施例】次に、本発明について図面を参照して説明す る。図1は本発明の一実施例の平面図である。 I Cチッ ブ1は矩形の個片として形成されており、その表面部に は所要の素子が形成され、かつ全面を絶縁膜で被覆した 上で、この絶縁膜の一部に導電膜を露呈させて複数個の 外部回路接続用のランド2を配設している。これらのラ ンド2には半田等をめっきしてパンプを形成するが、各 ランド2はICチップ1の表面の略全域にわたって等ピ ッチ寸法で、かつマトリックス状に配置している。この ランドのマトリックス配置は、図2に示すように、IC ペレットが個片に切断される前のウェハ3の段階におい ても全てのランドが等ピッチ寸法のマトリックスとなる 30 ようにして形成されている。この場合、ランド2のピッ チ寸法は可能な限り製品をシリーズ化し、同シリーズ内 では統一規格となるようにしている。

【0008】したがって、この構成のICペレットによ れば、所定数のランドを配設する場合には従来のランド 配置よりもランド2のピッチ寸法を大きくし、かつ各ラ ンド2の面積を大きくすることができる。 具体的な数値 を挙げると、ランド2の寸法を 150μm□程度、ピッチ 寸法は 400 µm程度とすることができる。したがって、 図3に示すように、各ランド2に半田でパンプ4を形成 し、ハイブリッド基板5に実装を行った場合でも、充分 な大きさのバンプで、しかも隣接するバンプが短絡する ことがない信頼性の高い実装を行うことが可能となる。 又、本来必要とされるランドの数が少ない場合でも、そ れ以上の所定数のランドが設けられることになるため、 パンプを利用した実装を行った場合に、1つのパンプ4 当たりにかかるICペレット自体の荷重が常に一定とな り、パンプの潰れを防止して安定な実装が可能となる。 【0009】更に、ランドを一定の寸法、ピッチでマト リックス状に配置することで、ICペレットの種類によ

らずランドを規格化することができ、パンプ形成のため

3

のマスクを共有化することができる。同様に、機能検査用プロープカードもある程度の共有化が可能となる。即ち、大き目のプロープカードが1台あれば、このプロープカードがカバーする領域に含まれるサイズのICペレットは、全て電気的なコンタクトが取れ、検査が可能となる。尚、この場合、隣接する他のペレットにまでプローブが及ぶが、処理装置側の設定でオープン状態としておけば問題はない。又、ICチップが搭載される基板のパターン設計においても、これまでにない大幅な標準化が可能となり、例えば、ICペレットの種類毎に各IC 10ペレットのランドの位置情報等を収集、照合する必要がなくなり、基板の設計の容易化が可能となる。

### [0010]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、複数個のランドをICペレット略全面にわたって所定のピッチ寸法でマトリックス状に配置することで、ランドの面積及びピッチ寸法を共に大きくすることができ、充分な大きさのバンブを可能とし、かつ隣接するバンブの短絡を防止して信頼性の高い実装を行うことができる。又、ICペレットの種類にかかわらずランドの規格化を可能と 20し、バンブ製造のためのマスクの共用化を図るとともに、電気的検査を行うプローブカードの共用化を図るこ

ともできる。更に、パンプに加えられる荷重を均一化 し、安定した実装を行うことも可能となる。したがっ て、本発明によれば、特に近年における半導体集積回路 装置の高密度化の傾向、設計TATの短縮傾向に対応す る手段として極めて有効なものとなる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のICペレットの一実施例の平面図である。

【図2】本発明のICペレットのウェハ状態の一部の平 10 面図である。

【図3】本発明のICペレットの実装状態の正面図である。

【図4】 従来の I Cペレットの一例の平面図である。

【図5】従来のICペレットの実装状態の正面図である。

### 【符号の説明】

- 1 ICペレット
- 2 外部回路接続用ランド
- 3 ウェハ
- 20 4 パンプ
  - 5 ハイプリッド基板

